

8050M (3DA8050M)

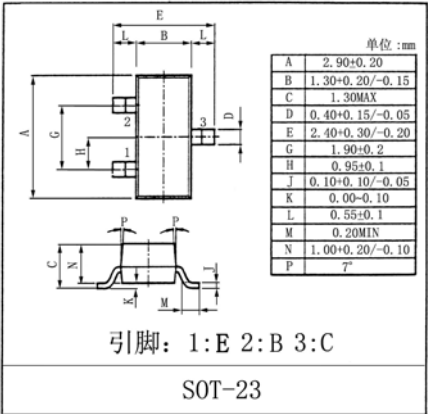
硅 NPN 半导体三极管/SILICON NPN TRANSISTOR

用途:用于功率放大电路。/Purpose: Power amplifier applications.

特点:与 8550M(3CA8550M)互补。/Features: Complementary pair with 8550M(3CA8550M).

极限参数/Absolute maximum ratings(Ta=25℃)

参数符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
V_{CB0}	40	V
V_{CE0}	25	V
V_{EB0}	6.0	V
I_C	1.5	A
I_B	0.5	A
P_C	625	mW
T_j	150	℃
T_{stg}	-55~150	℃



电性能参数/Electrical characteristics(Ta=25℃)

参数符号 Symbol	测试条件 Test condition		数值 Rating			单位 Unit
			最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	
V_{CB0}	$I_C=0.1mA$	$I_E=0$	40			V
V_{CE0}	$I_C=2.0mA$	$I_B=0$	25			V
V_{EB0}	$I_E=0.1mA$	$I_C=0$	6.0			V
I_{CB0}	$V_{CB}=35V$	$I_E=0$			0.1	μ A
I_{EB0}	$V_{EB}=6.0V$	$I_C=0$			0.1	μ A
$h_{FE(1)}$	$V_{CE}=1.0V$	$I_C=100mA$	85		300	
$h_{FE(2)}$	$V_{CE}=1.0V$	$I_C=800mA$	40			
$h_{FE(3)}$	$V_{CE}=1.0V$	$I_C=5.0mA$	45			
$V_{CE(sat)}$	$I_C=800mA$	$I_B=80mA$		0.28	0.5	V
$V_{BE(sat)}$	$I_C=800mA$	$I_B=80mA$		0.98	1.2	V
V_{BE}	$V_{CE}=1.0V$	$I_C=10mA$		0.66	1.0	V
f_T	$V_{CE}=10V$	$I_C=50mA$	100	190		MHz
C_{ob}	$V_{CB}=10V$	$I_E=0$ $f=1.0MHz$		9.0		pF

$h_{FE(1)}$ 分档、印章/ $h_{FE(1)}$ Classifications、Marking:

$h_{FE(1)}$ 分档 $h_{FE(1)}$ Classifications	B	C	D
$h_{FE(1)}$ 范围 $h_{FE(1)}$ Range	85~160	120~200	160~300
印章 Marking	HY1B	HY1C	HY1D

